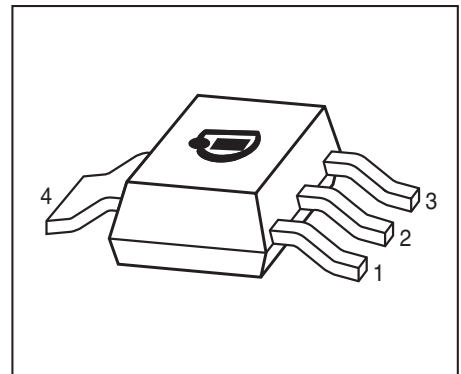


Silicon NPN Transistors

- For AF driver and output stages
- High collector current
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary types: BDP948, BDP950, BDP954 (PNP)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BDP947	BDP947	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223
BDP949	BDP949	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223
BDP953	BDP953	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage BDP947 BDP949 BDP953	V_{CEO}	45 60 100	V
Collector-base voltage BDP947 BDP949 BDP953	V_{CBO}	45 60 120	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	5	
Collector current	I_C	3	
Peak collector current, $t_p \leq 10$ ms	I_{CM}	5	
Base current	I_B	200	mA
Peak base current, $t_p \leq 10$ ms	I_{BM}	500	
Total power dissipation- $T_S \leq 100$ °C	P_{tot}	5	W
Junction temperature	T_j	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}	≤ 10	K/W

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

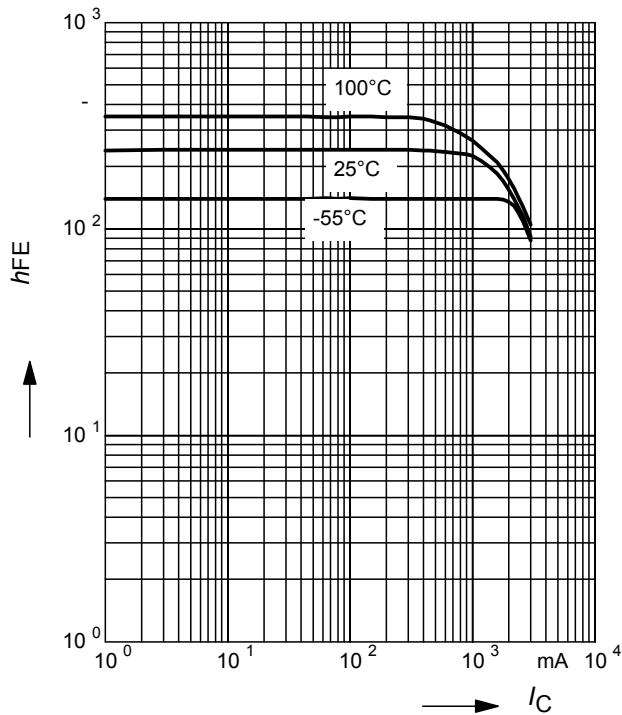
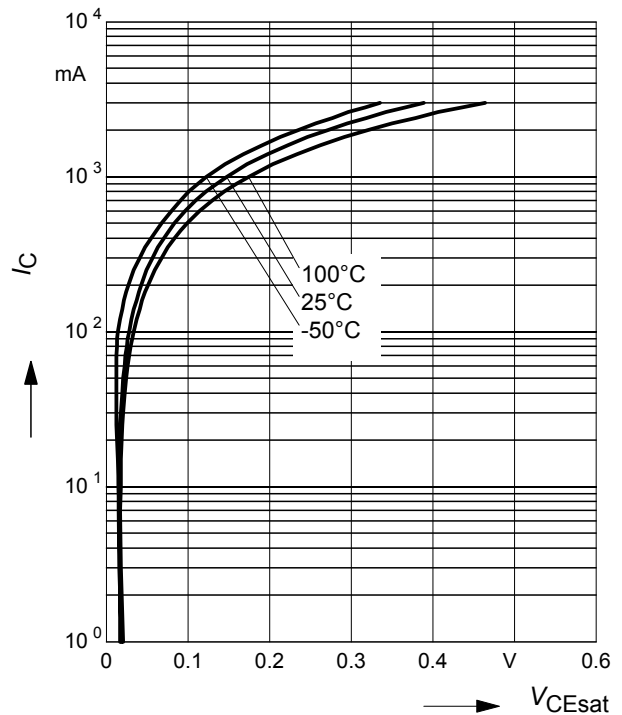
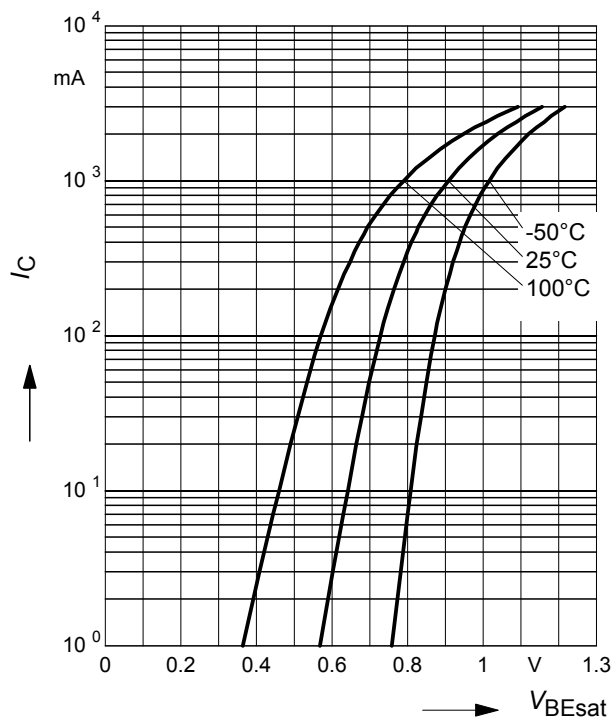
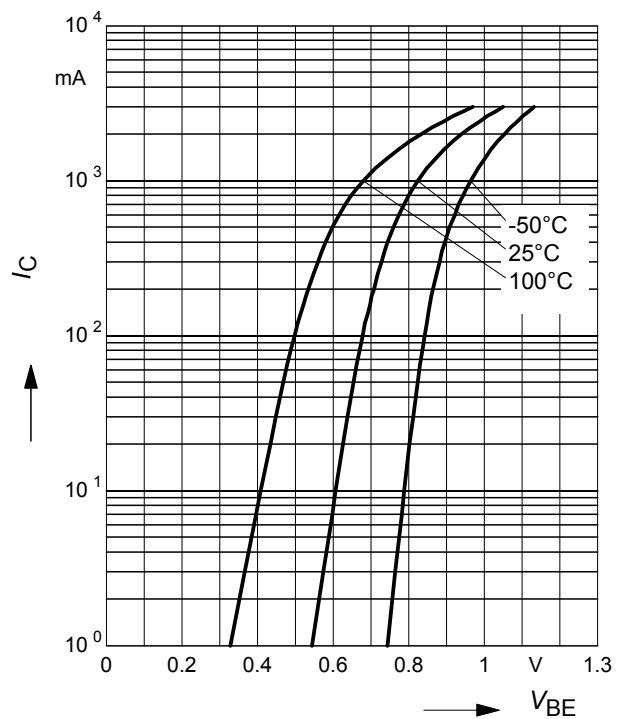
Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BDP947 $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BDP949 $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0$, BDP953	$V_{(BR)CEO}$	45 60 100	- - -	- - -	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$, BDP947 $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $I_E = 0$, BDP949 $I_C = 0$, $I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$, BDP953	$V_{(BR)CBO}$	45 60 120	- - -	- - -	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 45\text{ V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 45\text{ V}$, $I_E = 0$, $T_A = 150\text{ }^\circ\text{C}$	I_{CBO}	- -	- -	0.1 20	
Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 4\text{ V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	100	nA
DC current gain ²⁾ $I_C = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_C = 500\text{ mA}$, $V_{CE} = 1\text{ V}$ $I_C = 2\text{ A}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$, BDP947, BDP949 $I_C = 2\text{ A}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$, BDP953	h_{FE}	25 100 50 15	- - - -	- 475 - -	-
Collector-emitter saturation voltage ²⁾ $I_C = 2\text{ A}$, $I_B = 0.2\text{ A}$	V_{CEsat}	-	-	0.5	V
Base emitter saturation voltage ²⁾ $I_C = 2\text{ A}$, $I_B = 0.2\text{ A}$	V_{BEsat}	-	-	1.3	

AC Characteristics

Transition frequency $I_C = 50\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$	f_T	-	100	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{cb}	-	25	-	pF

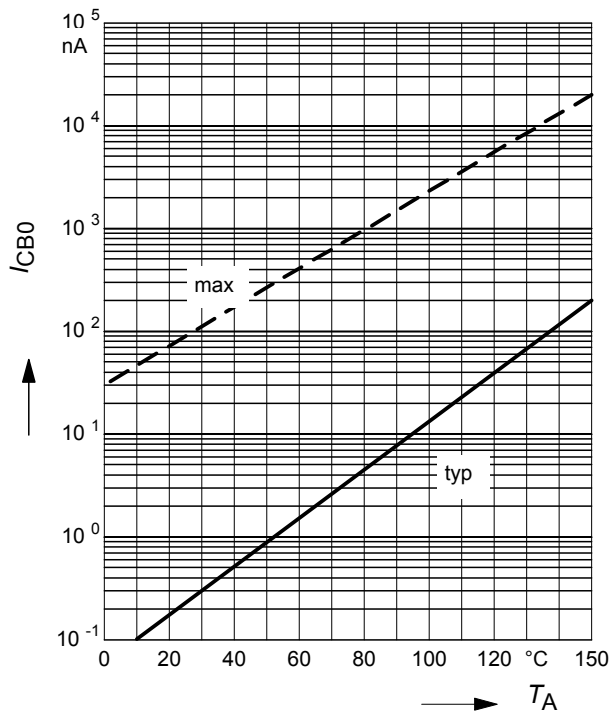
¹For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

²Pulse test: $t < 300\mu\text{s}$; $D < 2\%$

DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$
 $V_{CE} = 2 \text{ V}$

Collector-emitter saturation voltage
 $I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 10$

Base-emitter saturation voltage
 $I_C = (V_{BEsat}), h_{FE} = 10$

Collector current $I_C = f(V_{BE})$
 $V_{CE} = 2 \text{ V}$


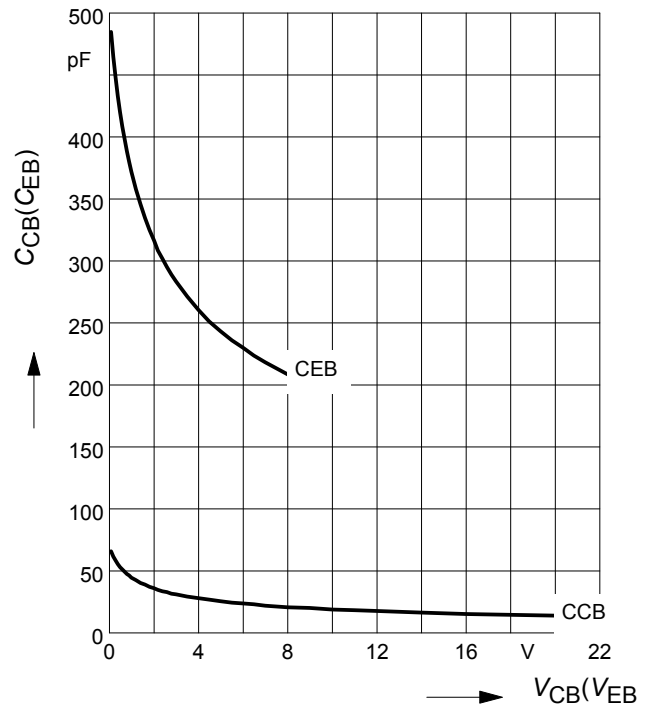
Collector cutoff current $I_{CBO} = f(T_A)$

$V_{CB} = 45 \text{ V}$

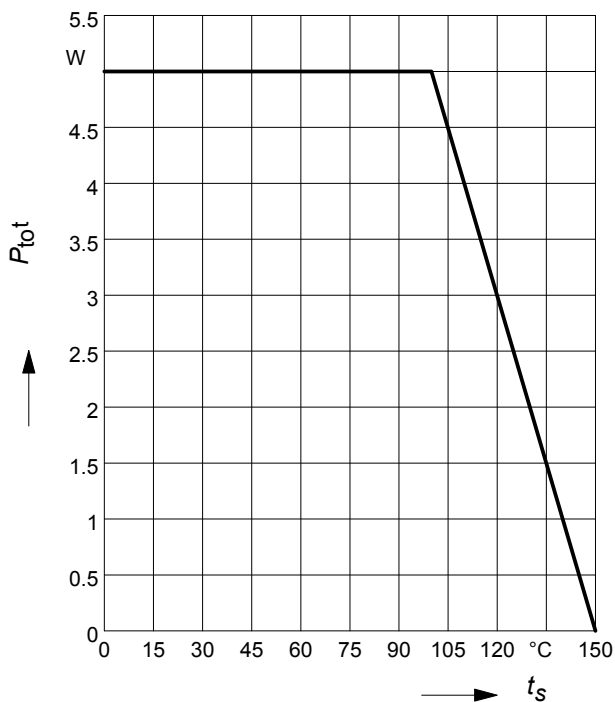


Collector-base capacitance $C_{cb} = f(V_{CB})$

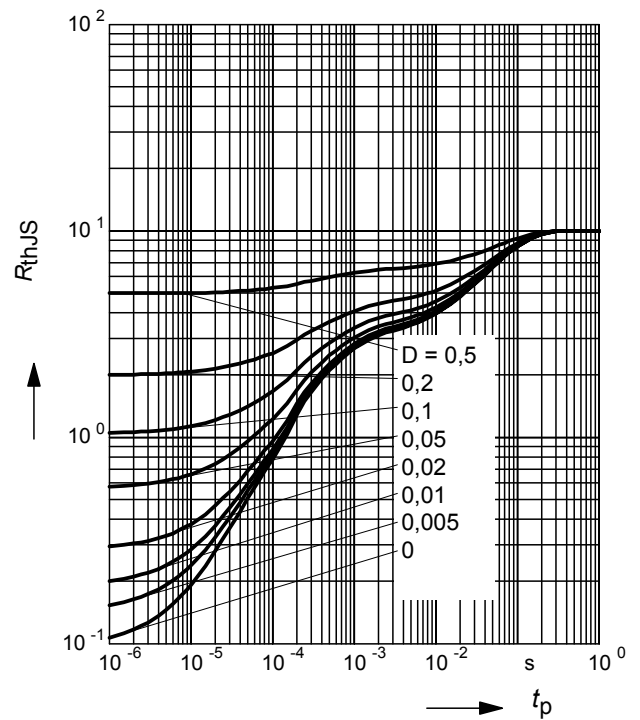
Emitter-base capacitance $C_{eb} = f(V_{EB})$



Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

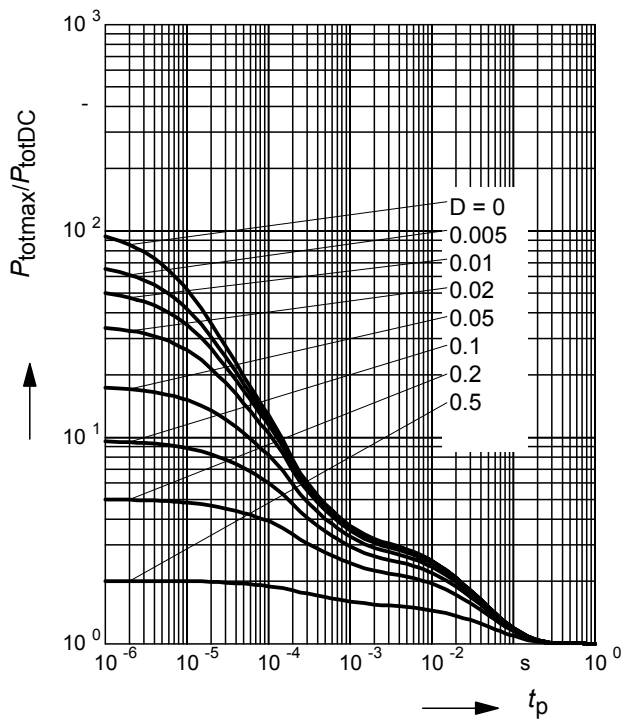


Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$

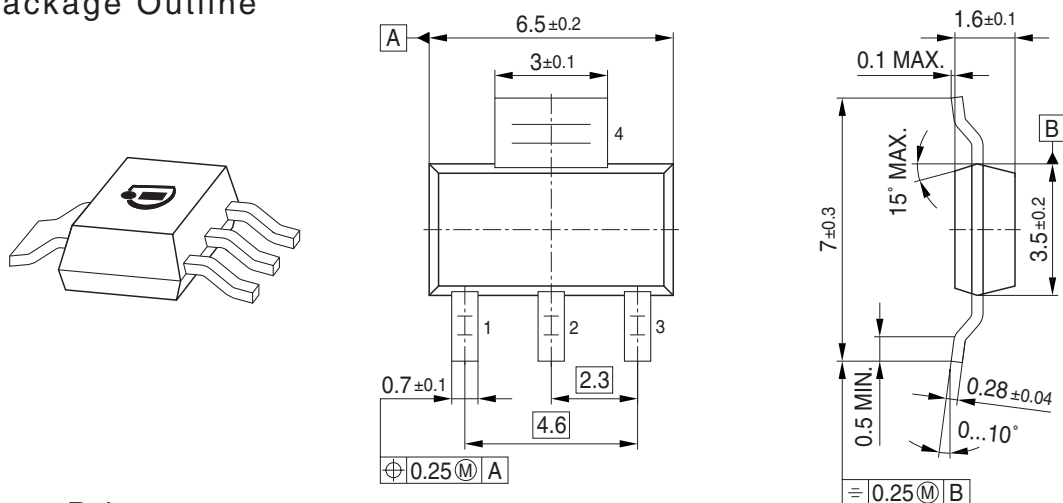


Permissible Pulse Load

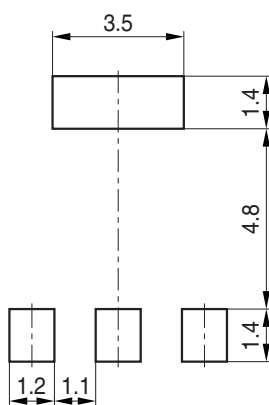
$$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$$



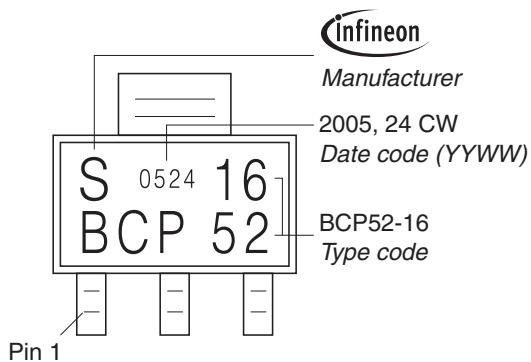
Package Outline



Foot Print

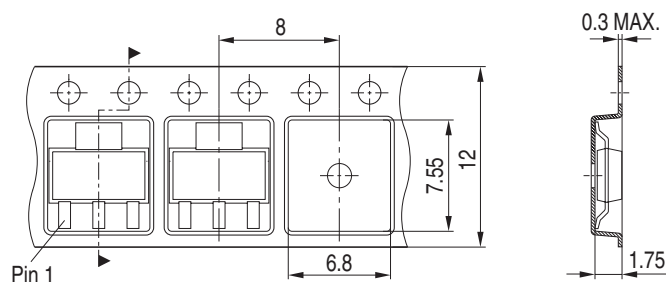


Marking Layout (Example)



Packing

Reel $\varnothing 180 \text{ mm}$ = 1.000 Pieces/Reel
 Reel $\varnothing 330 \text{ mm}$ = 4.000 Pieces/Reel



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.